

Micron 的混合内存立方在下一代超级计算机應用中获得高度赞扬

Micron 新款设备支持千萬億次 (Petascale) 超級電腦，突破記憶體牆以解決行業在
超級電腦領域面臨的最大挑戰

愛達荷州博依西，2013 年 11 月 8 日(GLOBE NEWSWIRE) -- Micron Technology, Inc., (納斯達克代碼：MU) 今日宣佈正在規畫將其混合記憶體立方 (HMC) 適應於 petascale 超級電腦系統，這代表著記憶體技術向前邁出的巨大的一步。HMC 是專門為需要訪問低能耗、高頻寬記憶體的應用而設計的，這些是超級電腦最重要的要求。其他應用包括資料包處理、資料包緩衝或存儲、以及處理器加速等。

在 11 月 19 至 21 日在丹佛舉辦的“2013 超級計算大會”上，Micron 和全球超級計算領袖 Fujitsu 均將推出各自的展示板，以展示 Fujitsu 下一代超級電腦樣機採用的 HMC 設備的特點。

超級計算是一項使科學家和工程師能處理複雜模擬的重要技術，這些模擬能推動研究和開發，使其能探索我們宇宙結構的基本問題。處理這種級別的問題需要極高的資料移動能力。採用 HMC 釋放超級電腦內多核處理器架構的潛力可取得非凡的性能和效率。

“Fujitsu 的設計師和工程師們很早就看到混合記憶體立方的價值，這種記憶體有助於將他們的系統提升至下一級的水準”，Micron 公司 DRAM 解決方案集團副總裁 Brian Shirley 說。“我們期盼著幫助 Fujitsu 立即提高處理最先進計算問題的能力”。

“HMC 給我們的系統設計師們留下了非常深刻的印象，因為它使新的記憶體系統設計能支援我們對頻寬和超級緊湊的外形尺寸日益增長的要求，並優化了每記憶位的能耗”，Fujitsu 下一代計算技術部主管 Yuji Oinaga 說，“關於應用軟體性能和效率的優化，最重要的提高 B（位元組）/F（每秒浮點運算率 FLOPS）比，而 HMC 代表了超級計算用記憶體的新性能標準”。

這是一個行業性的突破，HMC 採用了先進的矽穿孔（TSV）垂直導連技術-即將各個晶片的堆疊電氣地連接在一起，並採用 Micron 先進的 DRAM 共同構成高性能邏輯電路。Micron 的 HMC 頻寬史無前例的高，可達 160GB/s，而每位功耗比採用現有技術的器件少 70%，這大幅度地降低了用戶的擁有權總成本（TCO）。

業界領袖者和有影響人士認為 HMC 為 DRAM 的性能改進率與處理器資料能耗率之間日益增大的差距提供了一個期待已久的答案。Micron 的 HMC 最近被主流電子刊物 EDN 和 EE 時報命名為“年度最佳記憶體產品”。

Micron 預計將於 2014 年下半年對容量為 2GB 和 4GB 的 HMC 設備進行批量生產。

關於 Micron

Micron Technology, Inc., 是全球領先的先進半導體解決方案供應商之一。通過它遍佈全球的運營，Micron 為先進的計算、使用者、網路、嵌入式和移動產品生產和銷售全套固態硬碟、DRAM、NAND 和 NOR 快閃記憶體，以及其他創新的記憶體技術、封裝方案和半導體系統。Micron 的普通股在納斯達克上市交易，代碼是 MU。欲瞭解有關美光科技公司的更多資訊，請訪問 www.micron.com。

(C)2013 Micron Technology, Inc.版權所有。資訊若有修改恕不另行通知。Micron 和 Micron orbit 徽標為 Micron Technology, Inc.的商標。其他商標分別為其各自所有者財產。本新聞稿包含有關混合記憶體立方的樣品供貨和批量生產的前瞻性陳述。實際情況或結果可能與前瞻性陳述中包括的內容不同。請參考 Micron 和證券交易委員會定期發佈的匯總檔，特別是 Micron 最新的 10-K 和 10-Q 表。這些檔包含並確定導致匯總檔中的內容與前瞻性陳述不同的重要因素（見“某些因素”）。儘管我們認為前瞻性陳述中所反映的預期是合理的，但我們不能保證其未來結果、活動程度、性能或成就。

聯繫方式：Micron 媒體連絡人：

Scott Stevens

+1-512-288-4050

sstevens@micron.com